

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия 755 состоит из логических микросхем, выполненных на основе транзисторно-транзисторной логики по полупроводниковой технологии с изоляцией р-п переходом.

Микросхемы предназначены для применения в гибридных интегральных микросхемах, микросборках, блоках и аппаратуре.

СОСТАВ СЕРИИ:

- 755ЛА1-1 - Два логических элемента 4И-НЕ
- 755ЛА2-1 - Логический элемент 8И-НЕ
- 755ЛА3-1 - Четыре логических элемента 2И-НЕ
- 755ЛА9-1 - Четыре логических элемента 2И-НЕ с открытым коллектором
- 755ЛИ1-1 - Четыре логических элемента 2И
- 755ЛИ6-1 - Два логических элемента 4И
- 755ЛН1-1 - Шесть логических элементов НЕ
- 755ЛР11-1 - Логический элемент 2-2И-2ИЛИ-НЕ и логический элемент 3-3И-2ИЛИ-НЕ

Корпус. Бескорпусное оформление.

Электрические параметры микросхем приведены в таблицах I-2.

Напряжение источника питания:

$$U_{ч.п.} = 5В \pm 10\%$$

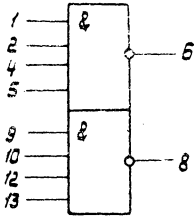
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Таблица I

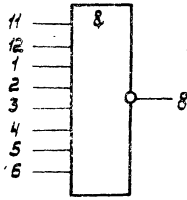
Обозначение параметра	755ЛА1-1	755ЛА2-1	755ЛА3-1	755ЛА9-1
$I^{\circ} \text{вх}$, мА, не более	-0,36	-0,4	-0,36	-0,36
$I^{\prime} \text{вх}$, мА, не более	0,02	0,02	0,02	0,02
$I \text{вх}$, проб., мА, не более	0,1	0,1	0,1	0,1
$U^{\circ} \text{вых}$, В, не более	0,4	0,4	0,4	0,4
$U^{\prime} \text{вых}$, В, не менее	2,5	2,5	2,5	2,5
$I^{\circ} \text{пот}$, мА, не более	2,2	1,1	4,4	4,4
$I^{\prime} \text{пот}$, мА, не более	0,8	0,5	1,6	1,6
$t_{зд,р}^{\circ}$, нс, не более	20	35	20	28
$t_{зд,р}^{\prime}$, нс, не более	20	20	20	32
C_H , пФ, не более	150	150	150	150

Таблица 2

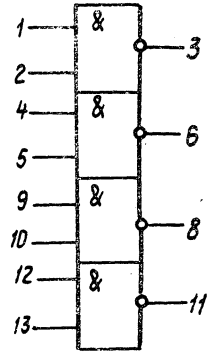
Обозначение параметра	755ЛИ1-1	755ЛИ6-1	755ЛИ1-1	755ЛР11-1
$I^{\circ} \text{вх}$, мА, не более	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36
$I^{\prime} \text{вх}$, мА, не более	0,02	0,02	0,02	0,02
$I \text{вх}$, проб., мА, не более	0,1	0,1	0,1	0,1
$U^{\circ} \text{вых}$, В, не более	0,4	0,4	0,4	0,4
$U^{\prime} \text{вых}$, В, не менее	2,5	2,5	2,5	2,5
$I^{\circ} \text{пот}$, мА, не более	8,8	4,4	6,6	2,8
$I^{\prime} \text{пот}$, мА, не более	4,4	2,4	2,4	1,6
$t_{зд,р}^{\circ}$, нс, не более	24	24	20	20
$t_{зд,р}^{\prime}$, нс, не более	24	24	20	20
C_H , пФ, не более	150	150	150	150



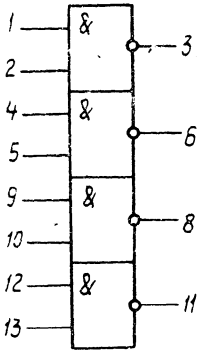
755Л1А1-I



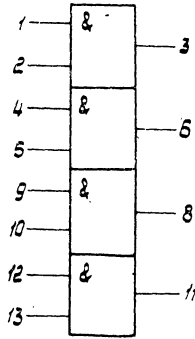
755Л1А2-I



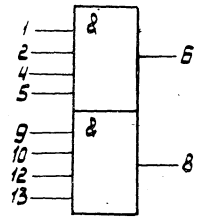
755Л1А3-I



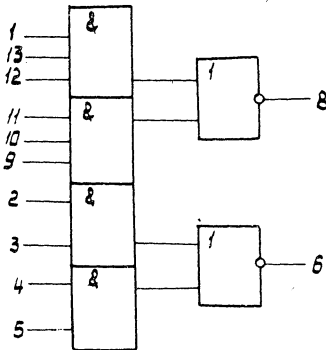
755Л1А9-I



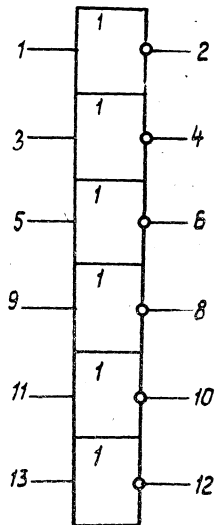
755Л1И1-I



755Л1И6-I



755Л1Р11-I



755Л1И1-I